

# EDB101S-EDB106S

Silicon Bridge Rectifiers

**VOLTAGE RANGE: 50 --- 400 V**

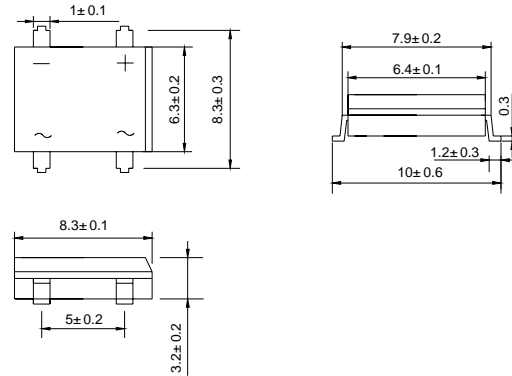
**CURRENT: 1.0 A**



## Features

- ◇ Rating to 400 VPRV
- ◇ Surge overload rating to 30 Amperes peak
- ◇ Ideal for printed circuit board
- ◇ Reliable low cost construction utilizing molded
- ◇ Lead solderable per MIL-STD-202 method 208
- ◇ Lead: silver plated copper, solderde plated
- ◇ Plastic material has UL flammability classification 94V-O
- ◇ Polarity symbols molded on body
- ◇ Weight: 1.0 grams

## DB-S



Dimensions in millimeters

## MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load. For capacitive load, derate by 20%.

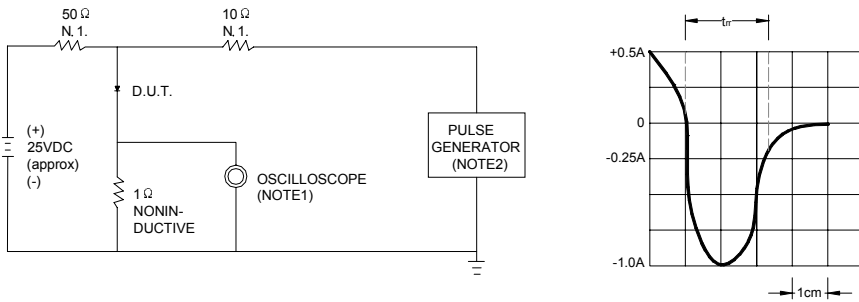
		EDB 101S	EDB 102S	EDB 103S	EDB 104S	EDB 105S	EDB 106S	UNITS
Maximum recurrent peak reverse voltage	$V_{RRM}$	50	100	150	200	300	400	V
Maximum RMS voltage	$V_{RMS}$	35	70	105	140	210	280	V
Maximum DC blocking voltage	$V_{DC}$	50	100	150	200	300	400	V
Maximum average forward Output current @ $T_A=55^\circ C$	$I_{F(AV)}$	1.0						A
Peak forward surge current 8.3ms single half-sine-wave superimposed on rated load	$I_{FSM}$	30.0						A
Maximum instantaneous forward voltage at 1.0 A	$V_F$	1.0						V
Maximum reverse current @ $T_A=25^\circ C$ at rated DC blocking voltage @ $T_A=100^\circ C$	$I_R$	10.0 1.0						$\mu A$ mA
Maximum reverse recovery time (NOTE 1)	$t_{rr}$	50						nS
Typical junction capacitance (NOTE 2)	$C_J$	15			10			pF
Operating junction temperature range	$T_J$	- 55 ---- + 150						°C
Storage temperature range	$T_{STG}$	- 55 ---- + 150						°C

NOTE: 1. Test conditions:  $I_F=0.5A$ ,  $I_R=1.0A$ ,  $I_{RR}=0.25A$ .

2. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts.

## Ratings AND Characteristic Curves

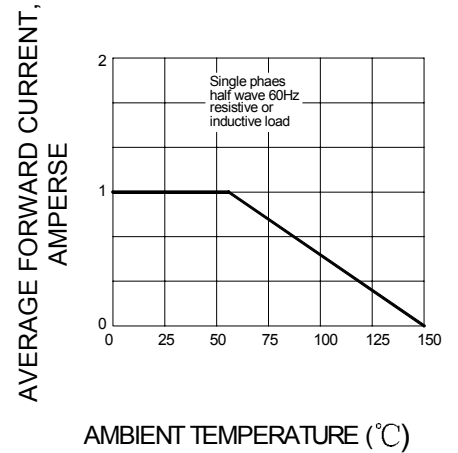
**FIG.1 – TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC**



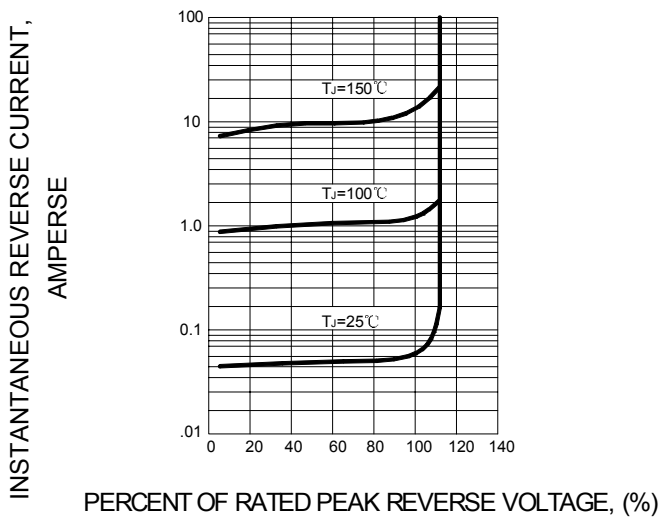
NOTES: 1. RISE TIME = 7ns MAX. INPUT IMPEDANCE = 1MΩ. 22pF  
2. RISE TIME = 10ns MAX. SOURCE IMPEDANCE = 50Ω

SET TIME BASE FOR  
10 ns / cm

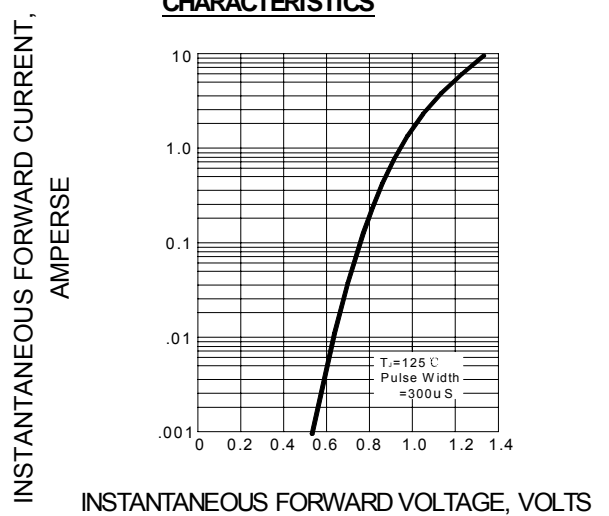
**FIG.2 – TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE**



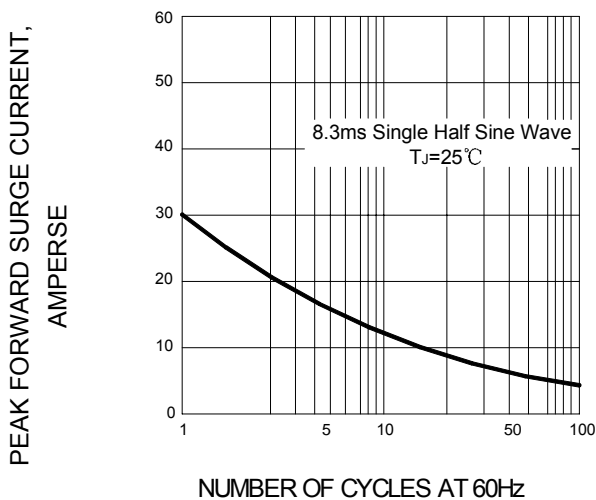
**FIG.3 – TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS**



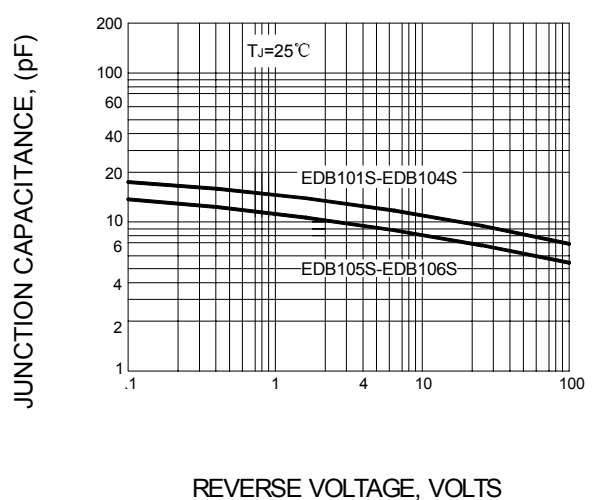
**FIG.4 – TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS**



**FIG.5 – MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT**



**FIG.6 – TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE**





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.